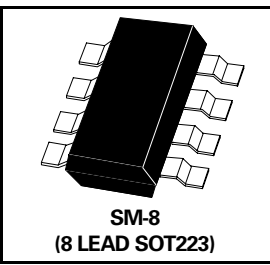
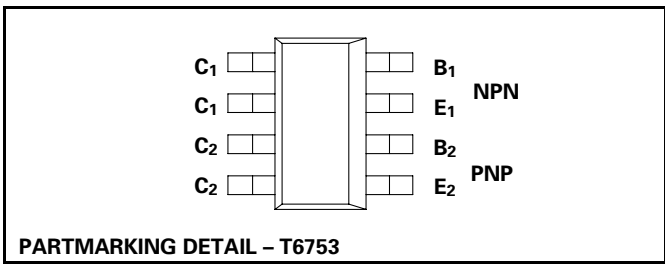


# SM-8 COMPLEMENTARY MEDIUM POWER TRANSISTORS

## ZDT6753

ISSUE 1 – JANUARY 1996



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	NPN	PNP	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	120	-120	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	100	-100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	6	-6	A
Continuous Collector Current	$I_C$	2	-2	A
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150		°C

### THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Total Power Dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}^*$ Any single die "on" Both die "on" equally	$P_{tot}$	2.25 2.75	W W
Derate above $25^\circ\text{C}^*$ Any single die "on" Both die "on" equally		18 22	mW/°C mW/°C
Thermal Resistance - Junction to Ambient* Any single die "on" Both die "on" equally		55.6 45.5	°C/W °C/W

\* The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a PCB with copper equal to 2 inches square.

# ZDT6753

## NPN TRANSISTOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120			V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	100			V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$
Collector Cutoff Current	$I_{CBO}$			0.1 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{CB}=100\text{V}$ $V_{CB}=100\text{V}, T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cutoff Current	$I_{EBO}$			0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=4\text{V}, I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.13 0.23	0.3 0.5	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.9	1.25	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		0.8	1	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	70 100 55 25	200 200 110 55	300		$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}$ $I_C=500\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$	140	175		MHz	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$ $f=100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$			30	pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$		80		ns	$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $I_{B1}=I_{B2}=50\text{mA}$
	$t_{off}$		1200		ns	

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$   
For typical characteristics graphs see FZT653 datasheet.

# ZDT6753

## PNP TRANSISTOR ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-120			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(SUS)}$	-100			V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cutoff Current	$I_{CBO}$			-0.1 -10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{CB} = -100\text{V}$ $V_{CB} = -100\text{V}$ , $T_{amb} = 100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cutoff Current	$I_{EBO}$			-0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.17 -0.30	-0.3 -0.5	V V	$I_C = -1\text{A}$ , $I_B = -100\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$ , $I_B = -200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.90	-1.25	V	$I_C = -1\text{A}$ , $I_B = -100\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8	-1.0	V	$I_C = -1\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	70 100 55 25	200 200 170 55	300		$I_C = -50\text{mA}$ , $V_{CE} = -2\text{V}$ $I_C = -500\text{mA}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$ , $V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}$ , $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$	100	140		MHz	$I_C = -100\text{mA}$ , $V_{CE} = 5\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$			30	pF	$V_{CE} = -10\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$		40		ns	$I_C = -500\text{mA}$ , $V_{CC} = -10\text{V}$ $I_{B1} = I_{B2} = 50\text{mA}$
	$t_{off}$		600		ns	

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$   
For typical characteristics graphs see FZT753 datasheet.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.